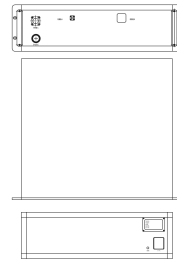


8000–12000 MHz GaN RF 功率放大系统，典型200 W

GaN系统覆盖8000–12000 MHz，典型饱和输出200 W、1 dB压缩点输出40 W。最小增益53 dB，典型增益平坦度±1.5 dB。



电气规格 · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	BW	8000	-	12000	MHz
1 dB 压缩点输出功率	P-1dB	-	40	-	W
RF 输出功率 @ PSAT	PSAT	-	200	-	W
功率增益 @ PSAT	Gp	53	-	-	dB
功率增益平坦度 @ PSAT	ΔGp	-	±1.5	-	dB
输入回波损耗	S11	-	-15	-	dB
200 W 条件下的谐波	H	-	-15	-	dBc
杂散信号 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
输入/输出阻抗	Impedance	-	50	-	Ω
工作电压	VDC	-	28	-	VDC
功率附加效率 @ 200W	Eff	-	20	-	%
DC 电流 @ 200W	IDD	-	36	-	A

绝对最大额定值

参数	额定值
不损坏器件的射频输入功率	+10 dBm 最大
Pout = 100 W 条件下的负载 VSWR	∞; 所有负载相位和幅度；连续
热过载	85 °C → 关断 (最大)

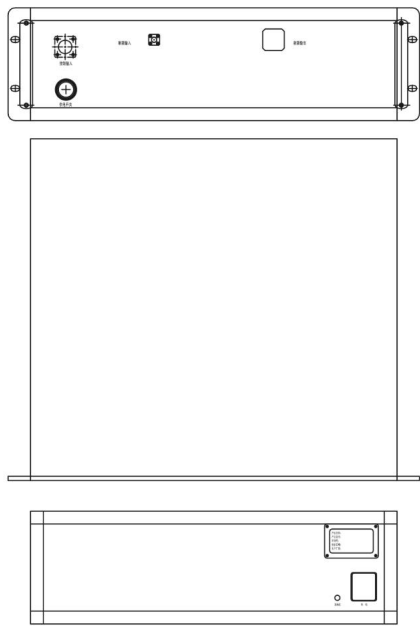
环境规格 · 设计目标；需按项目确认

参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作温度	-20	-	50	°C	-
存储温度	-25	-	65	°C	存储温度
相对湿度（无凝露）	-	-	95	%	-

机械规格

参数	数值	单位
外形尺寸	430 × 400 × 133 mm (最大)	mm
重量	15 kg (最大)	kg
射频输入连接器	SMA, 母头	-
射频输出连接器	N-K	-
直流/控制接口	混合型, D-Sub 7W2, 公头	-

机械外形尺寸图



所有尺寸单位为 mm [in]。

直流与控制接口

引脚编号	描述	规格
A1	A1 — 接地	接地
A2	A2 — 电源正极	+28V
1	1 — 使能	TTL 高电平（3.3 V）；内部下拉
2	2 — 接地	接地
3	3 — 温度检测输出	750 ±20 mV @25 °C; 10 mV/°C
4	4 — 电流检测输出	100 mV/A
5	5 — 接地	接地

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。